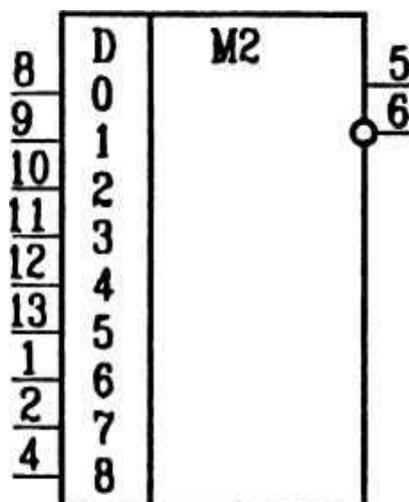


КР1533ИП5, КФ1533ИП5, ЭКФ1533ИП5

Микросхемы представляют собой девятиразрядную схему контроля четности. Имеют 2 выхода для контроля четности или нечетности. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г и 4306.14-А.

Назначение выводов: 1 - вход информационный D6; 2 - вход информационный D7; 3 - свободный; 4 - вход информационный D8; 5 - выход четности Q1; 6 - выход нечетности $\overline{Q1}$; 7 - общий; 8 - вход информационный D0; 9 - вход информационный D1; 10 - вход информационный D2; 11 - вход информационный D3; 12 - вход информационный D4; 13 - вход информационный D5; 14 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ИП5, КФ1533ИП5, ЭКФ1533ИП5

Таблица истинности

Число входов, на которое подан высокий уровень напряжения	Выход	
	Q1	$\overline{Q1}$
0, 2, 4, 6, 8	Н	Л
1, 3, 5, 7, 9	Л	Н

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания 5 В ± 10%
 Выходное напряжение низкого уровня ≤ 0,4 В
 Выходное напряжение высокого уровня ≥ 2,5 В
 Прямое падение напряжения на антизвонном диоде ≤ | -1,5 | В
 Ток потребления при $U_n = 5,5$ В ≤ 20 мА
 Входной ток низкого уровня ≤ | -0,2 | мА
 Входной ток высокого уровня ≤ 20 мкА

Входной пробивной ток	$\leq 0,1$ мкА
Выходной ток	$ -10 \dots -112 $ мА
Время задержки распространения при включении по выводам 5, 6	≤ 40 нс
Время задержки распространения при выключении по выводам 5, 6	≤ 45 нс
Емкость входа	≤ 5 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Максимальный выходной ток низкого уровня	4 мА
Максимальный выходной ток высокого уровня	$ -0,4 $ мА
Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более

265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В \pm 10%, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.